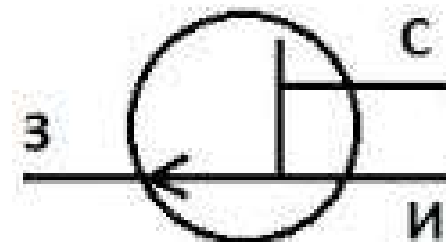
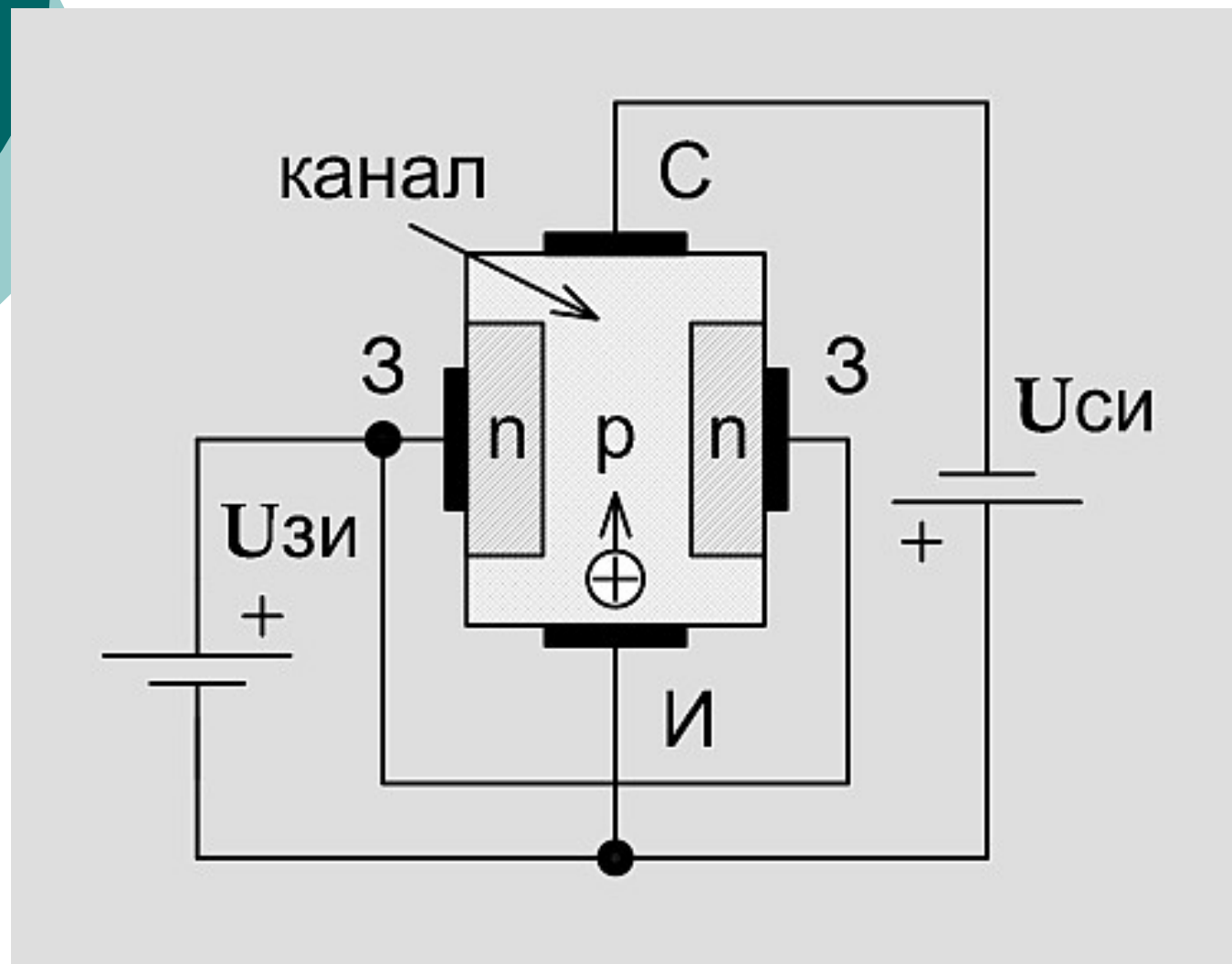


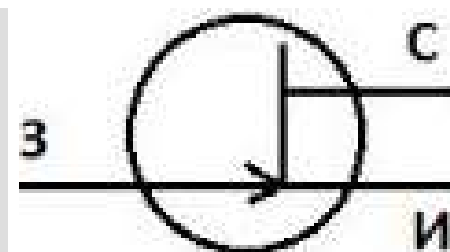
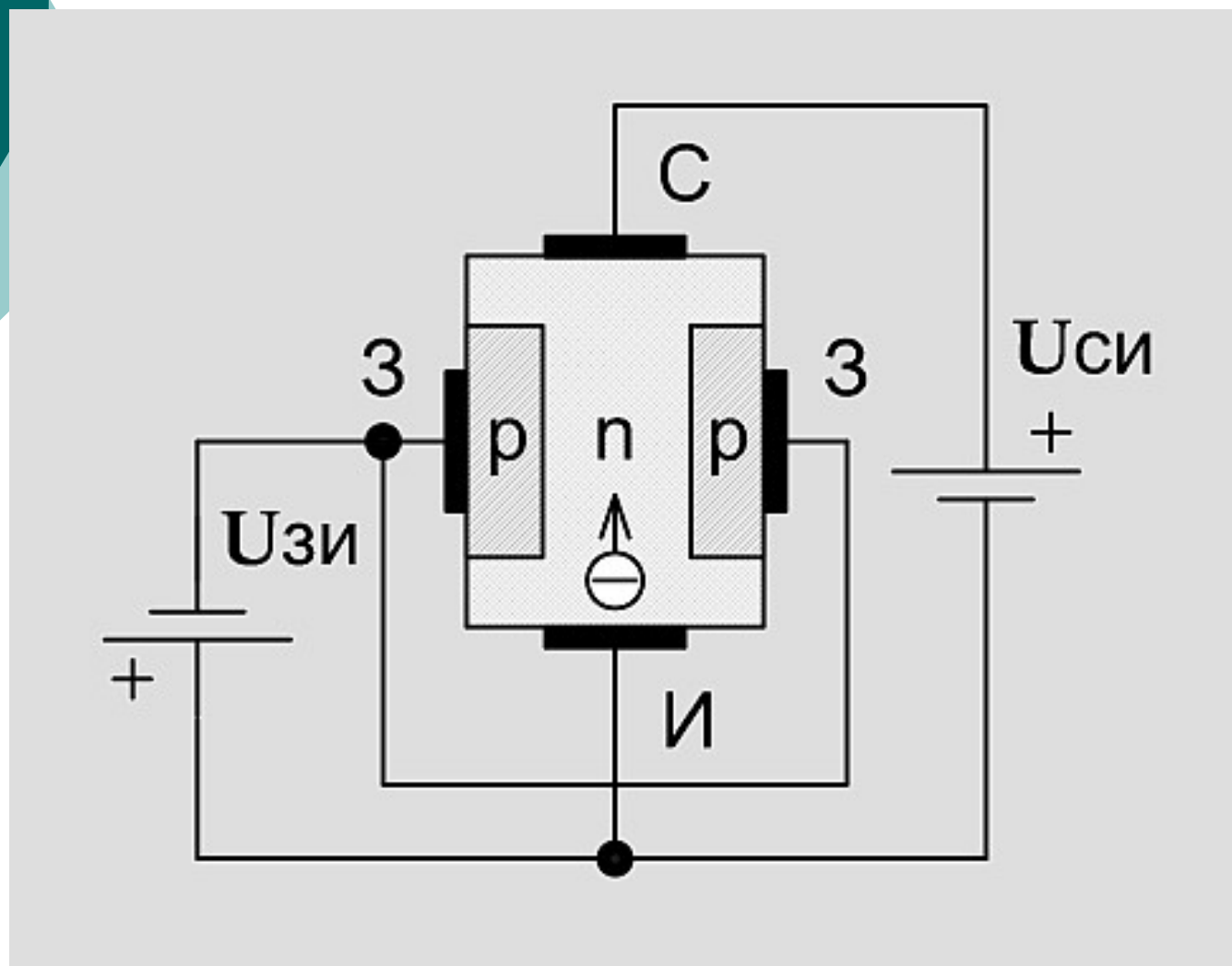
Полевые транзисторы



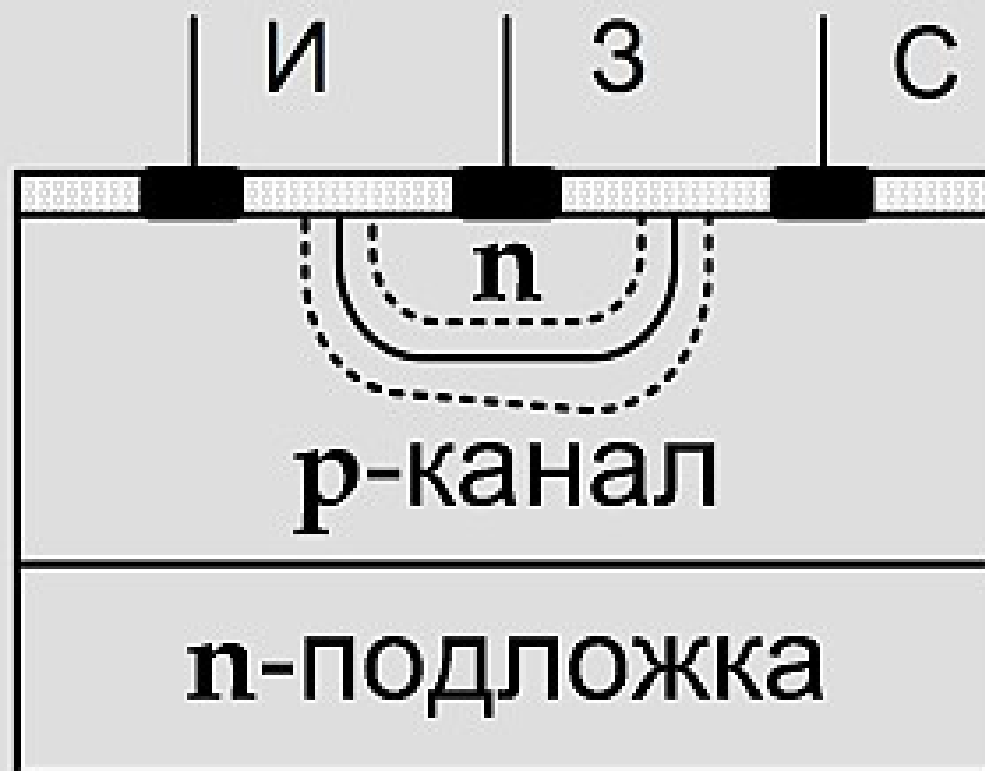
Полевой транзистор с р-п-переходом (канал р-типа)



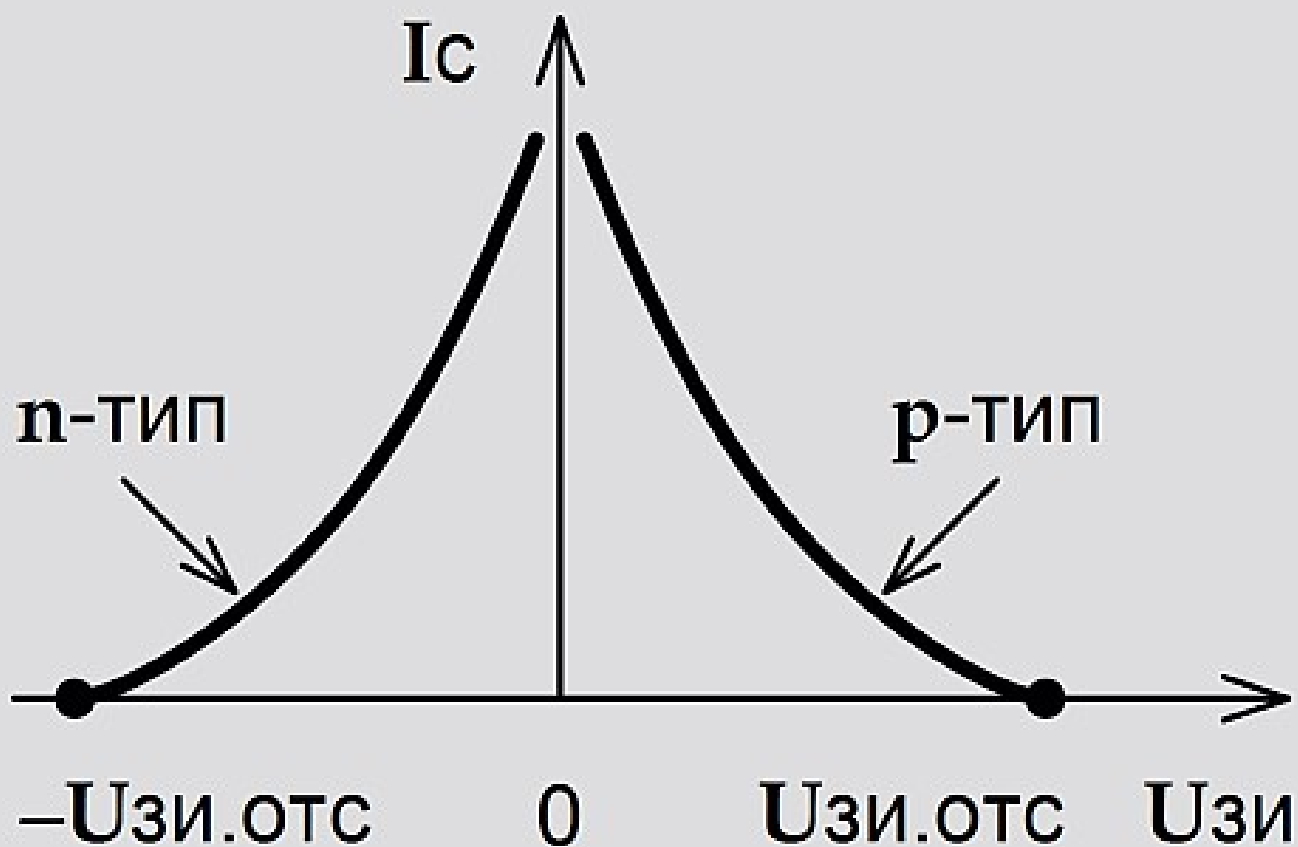
Полевой транзистор с р-п-переходом (канал n-типа)



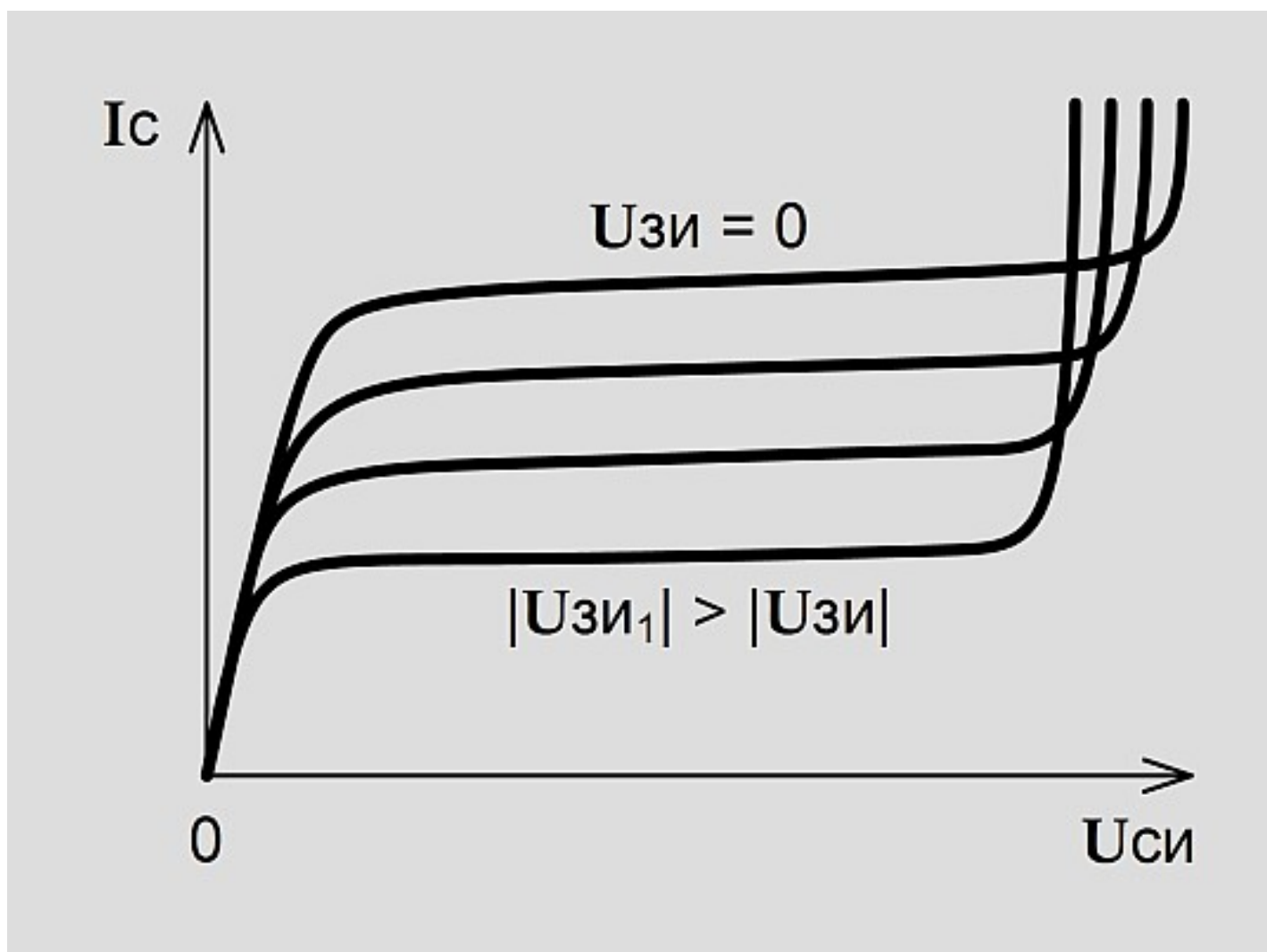
Принцип работы




Характеристики транзистора



Характеристики транзистора

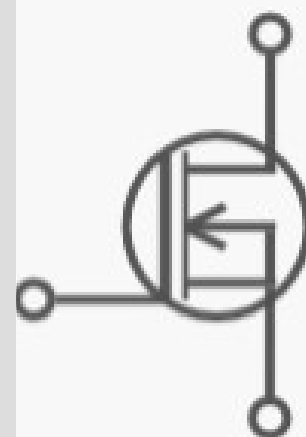
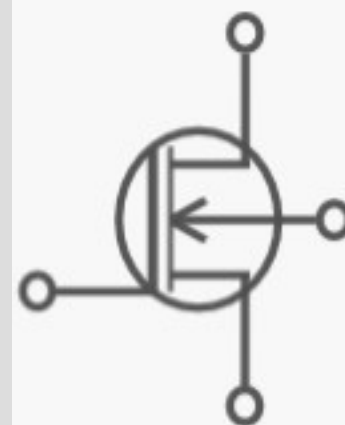
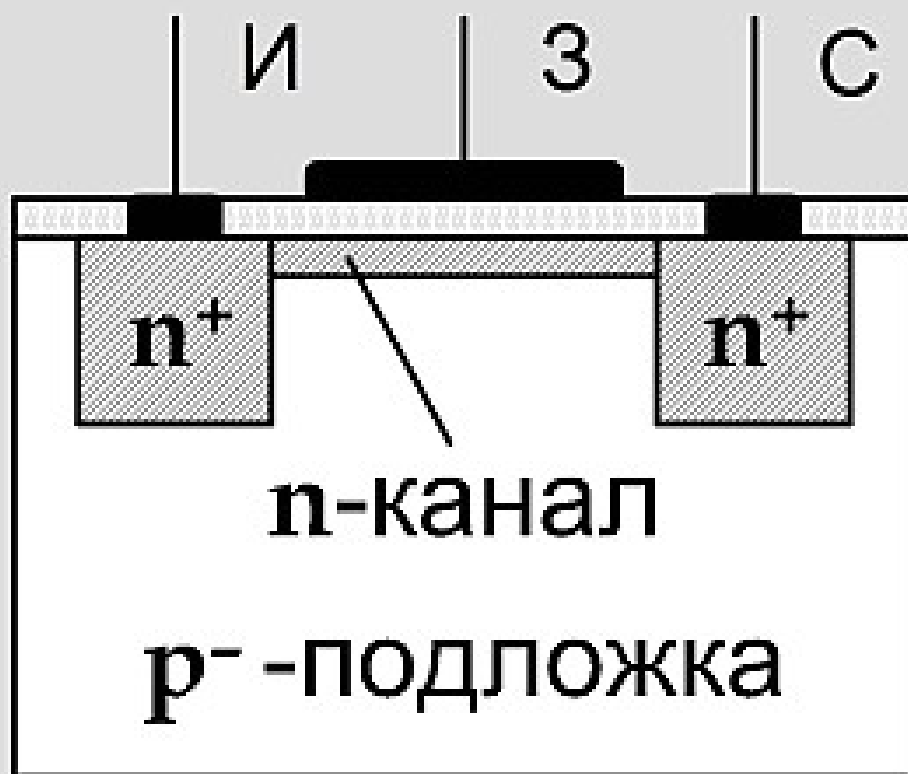




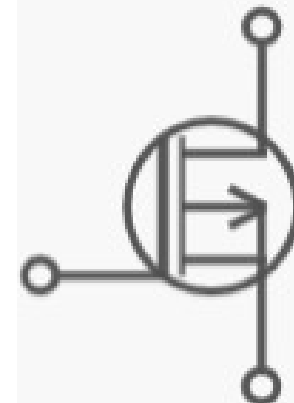
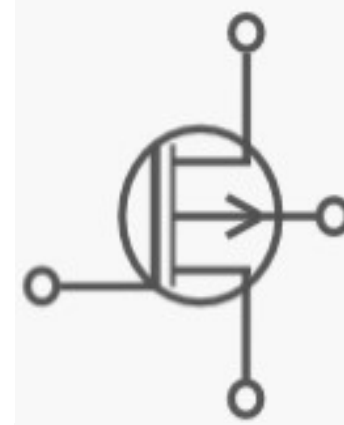
Полевые транзисторы с изолированным затвором

- Со встроенным каналом
- С индуцированным каналом

Полевые транзисторы со встроенным каналом

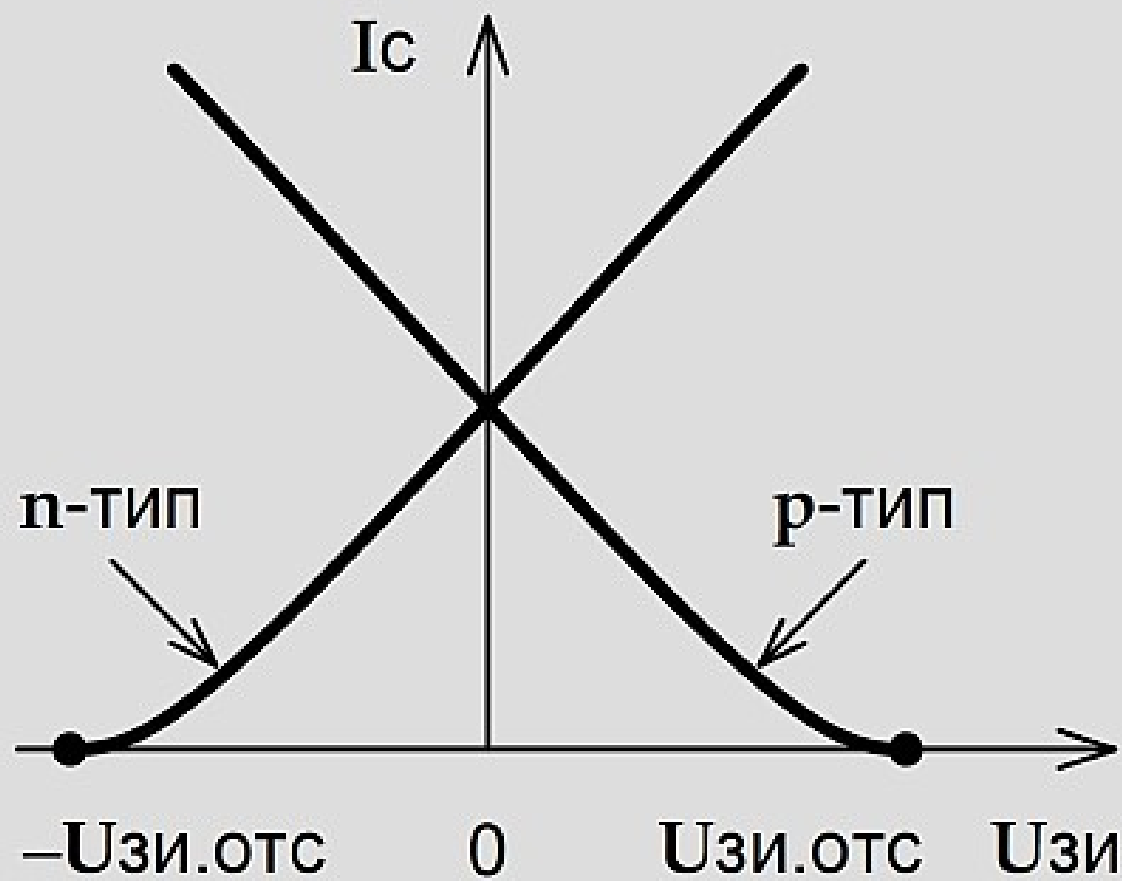


N-канал

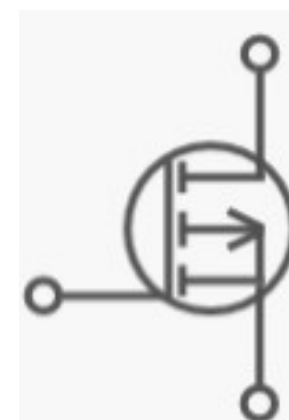
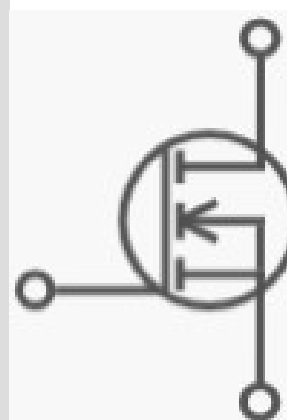
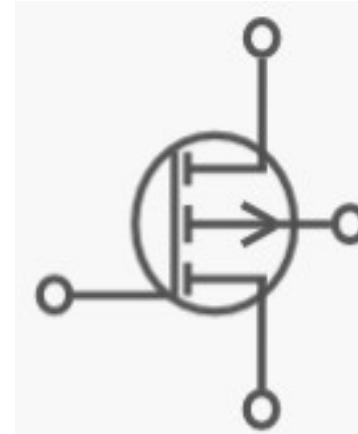
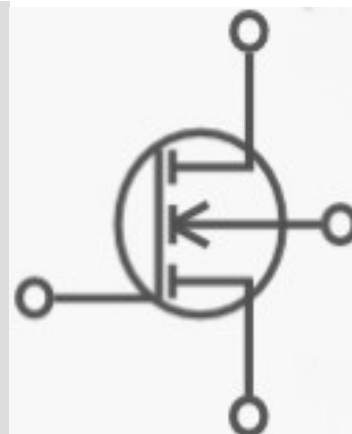
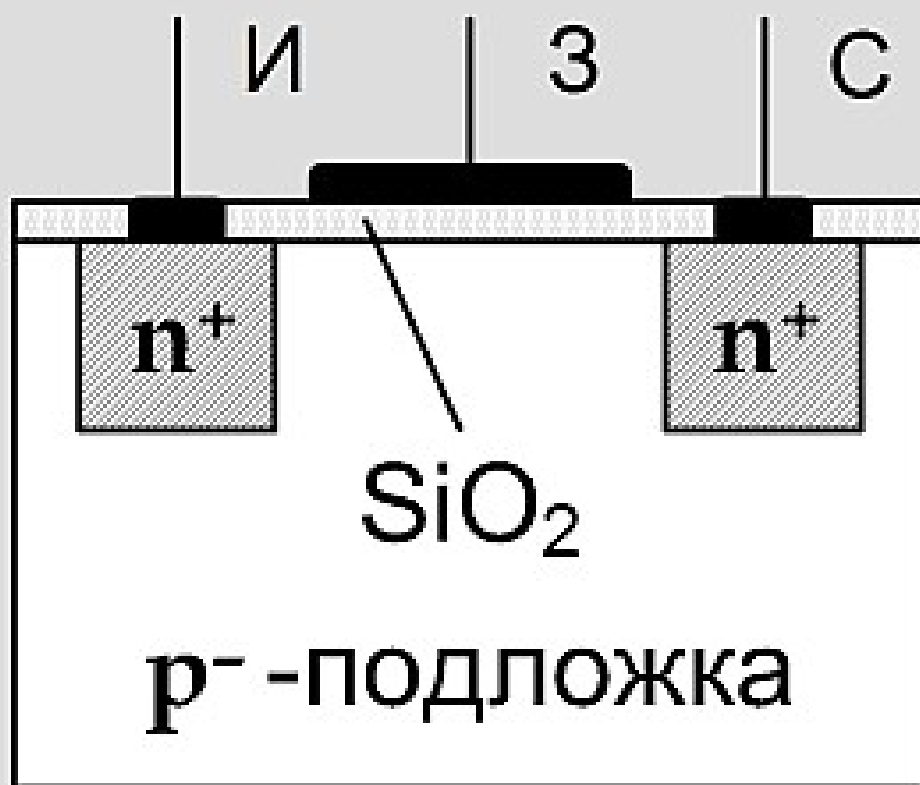


P-канал

Характеристики транзистора



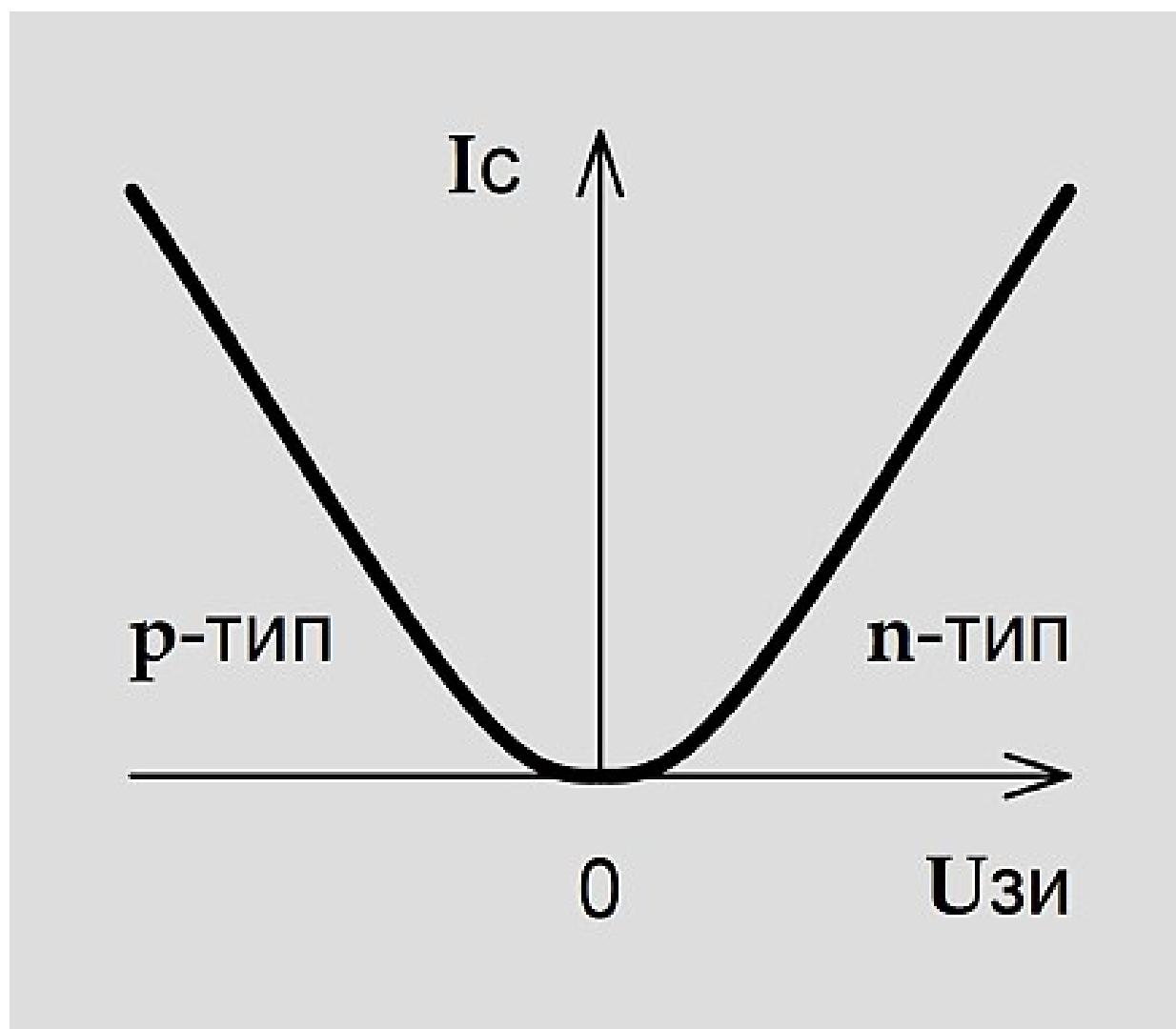
Полевые транзисторы с индуцированным каналом



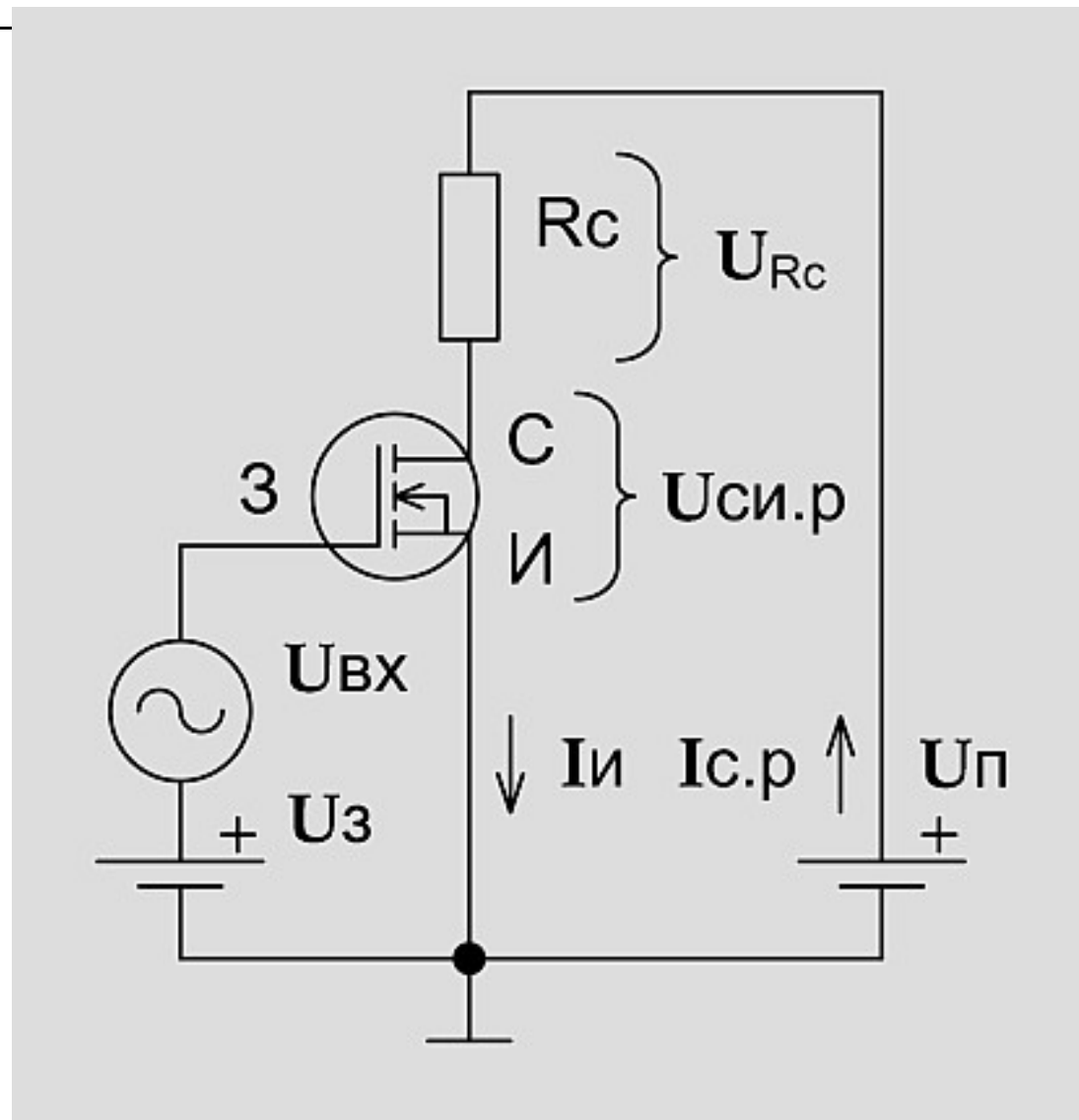
N-канал

P-канал

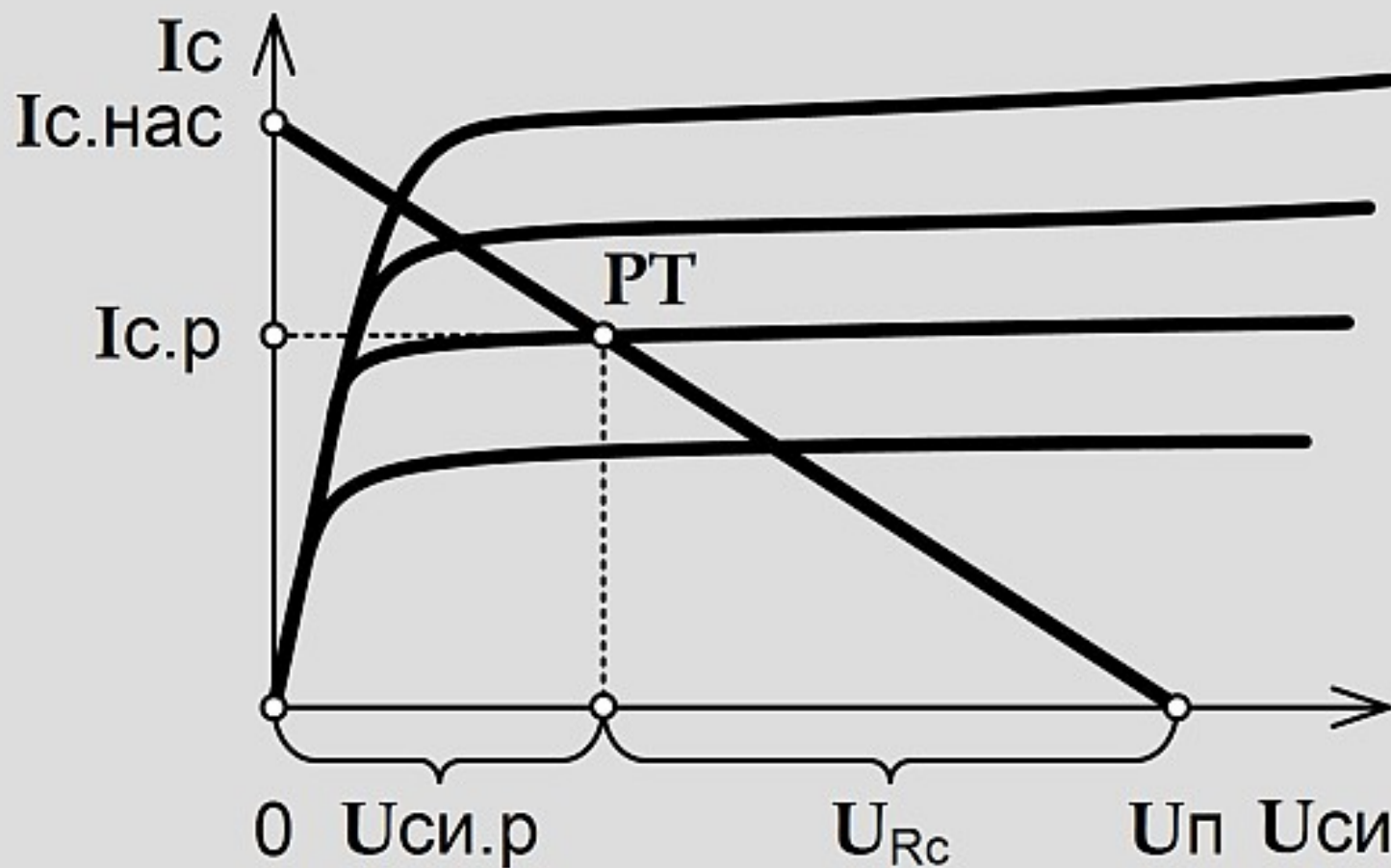
Характеристики транзисторов



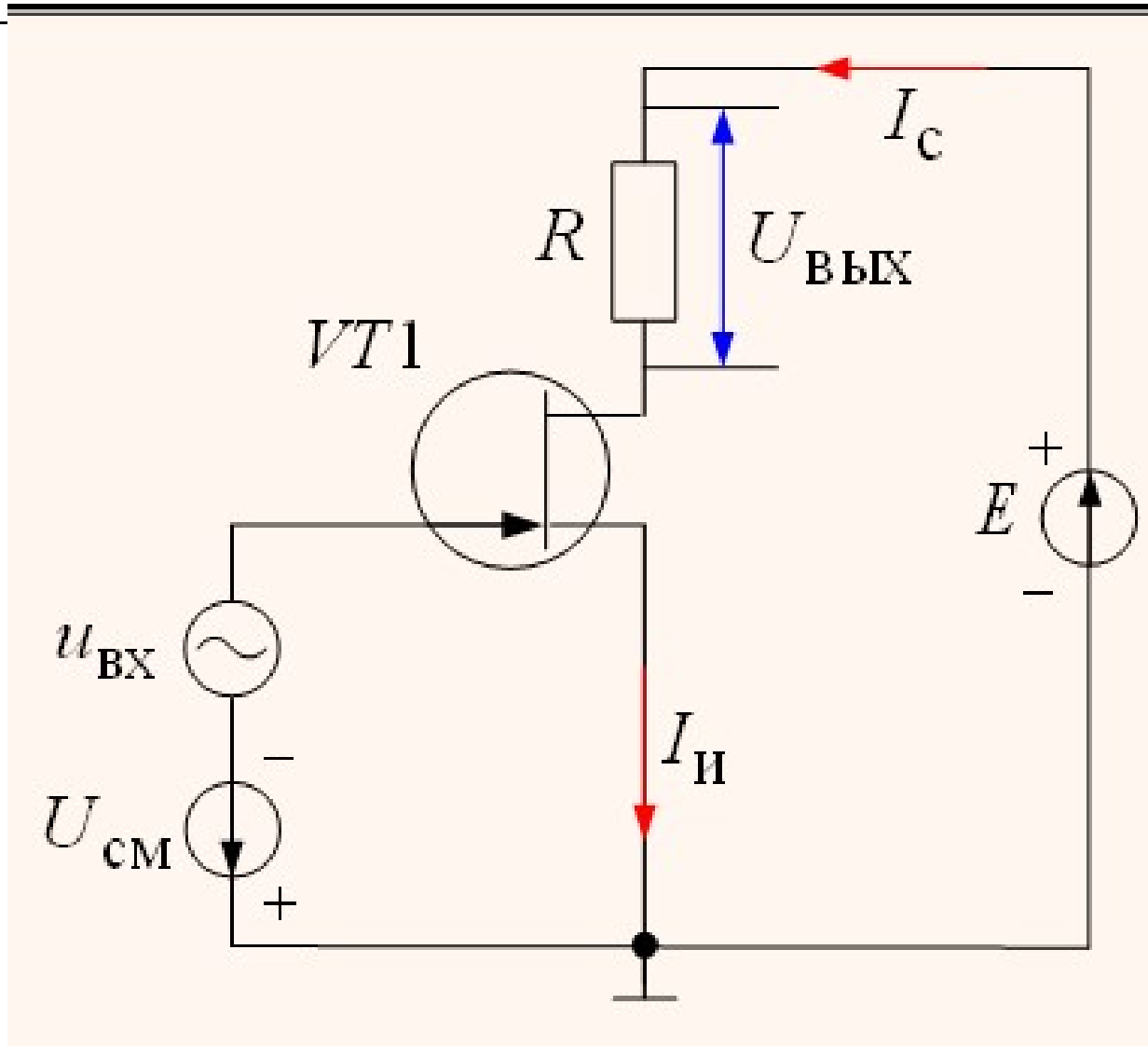
Динамический режим работы транзистора



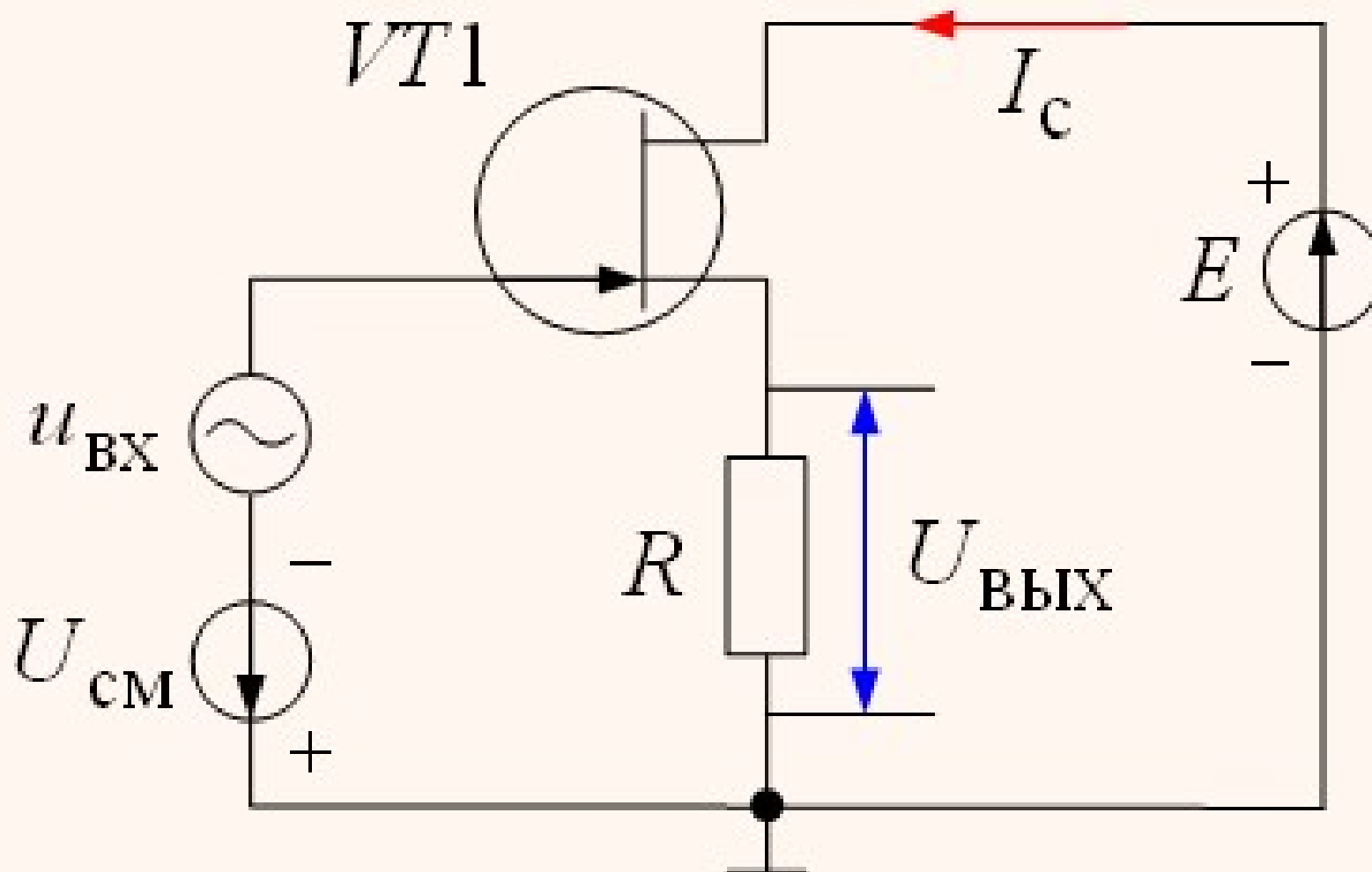
Характеристики транзистора



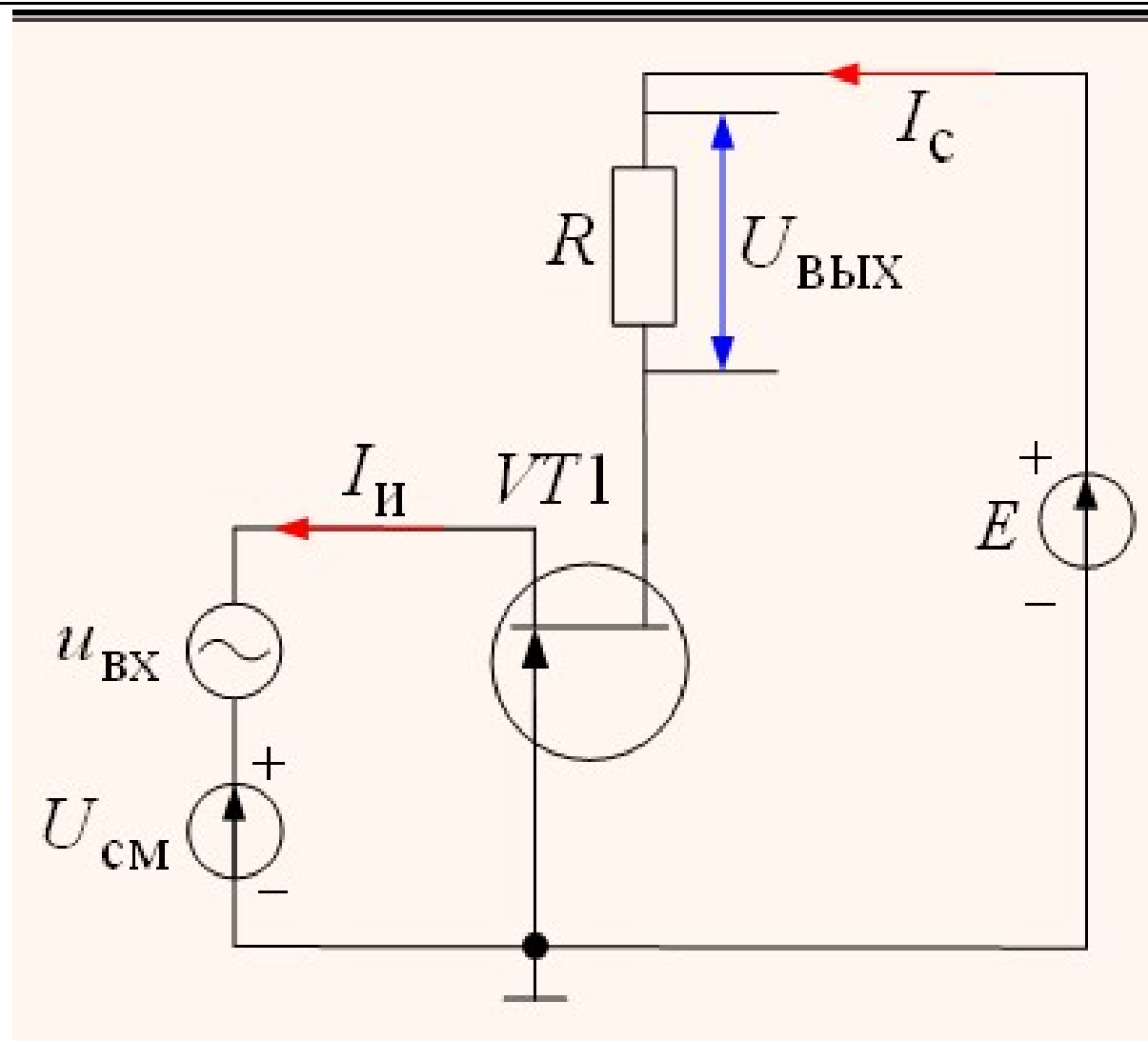
Подключение полевого транзистора с р-п-переходом



Подключение полевого транзистора с р-п-переходом



Подключение полевого транзистора с р-п-переходом





Особенности подключения мощных MOSFET

Затвор мощного MOSFET имеет высокую ёмкость, которую нужно не только заряжать, но и разряжать (нужен драйвер).

- Тепловой режим транзистора необходимо рассчитывать с учетом времени перехода из открытого состояния в закрытое и обратно.
- Напряжение на затворе нужно ограничивать
- Обязательно обеспечивать запас по току, напряжению, мощности